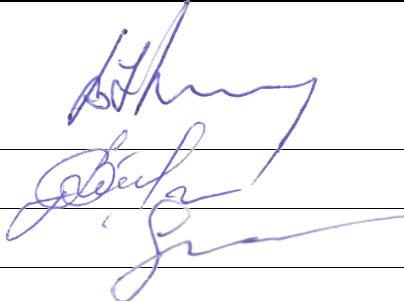
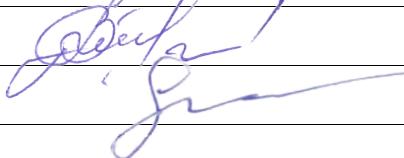
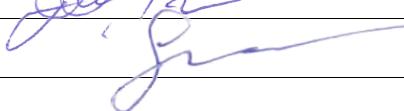


**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**  
**ПРИЕМ 2019 г.**  
**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная**

**Основы кристаллохимии**

Направление подготовки/ специальность	22.03.01 Материаловедение и технологии материалов	
Образовательная программа (направленность (профиль))	Материаловедение и технологии материалов	
Специализация	Материаловедение в машиностроении	
Уровень образования	высшее образование - бакалавриат	
Курс	4	семестр 8
Трудоемкость в кредитах (зачетных единицах)	3	

Заведующий кафедрой - руководитель отделения материаловедения (на правах кафедры)		V.A. Клименов
Руководитель ООП		O.YU. Ваулина
Преподаватель		C.B. Матренин

2020 г.

## 1. Роль дисциплины «Основы кристаллохимии» в формировании компетенций выпускника:

Элемент образовательной программы (дисциплина, практика, ГИА)	Семестр	Код компетенции	Наименование компетенции	Составляющие результатов освоения (дескрипторы компетенций)	
				Код	Наименование
Основы кристаллохимии	8	ПК(У)-6	Способен использовать на практике современные представления о влиянии микро- и нано- структуры на свойства материалов, их взаимодействии с окружающей средой, полями, частицами и излучениями	ПК(У)-6.36	Знает основные типы и параметры кристаллических решеток.
				ПК(У)-6.У6	Умеет определять параметры кристаллических решеток (тип решетки, координационное число, базис, индицирование плоскостей, направлений).
				ПК(У)-6.В6	Владеет методами определения параметров кристаллических решеток.
		ДПК(У)-1	Способен применять знания об основных типах современных неорганических и органических материалов, принципах выбора материалов для заданных условий эксплуатации с учетом требований технологичности, экономичности, надежности и долговечности, экологических последствий их применения при проектировании высокотехнологичных процессов	ДПК(У)-1.36	Знает пространственное расположение и химическую связь атомов в кристалле
				ДПК(У)-1.У6	Умеет устанавливать химическую связь атомов в кристаллах, а также зависимость физических и химических свойств кристаллических веществ от их строения
				ДПК(У)-1.В5	Владеет знаниями о взаимосвязи между физическими и химическими свойствами кристаллов от их строения

## 2. Показатели и методы оценивания

Планируемые результаты обучения по дисциплине		Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование раздела дисциплины	Методы оценивания (оценочные мероприятия)
Код	Наименование			
РД-1	Знать элементы симметрии полиэдров и структур, символы узлов, ребер и граней, основы кристаллохимии.	ПК(У)-6	Раздел 1. Симметрия полиэдров. Раздел 2. Симметрия, операции и элементы симметрии. Закрытые симметрические преобразования.	Презентация
РД-2	Уметь определять элементы симметрии точечных и пространственных групп, координационное число и координационный многогранник, описывать основные типы структур.	ПК(У)-6	Раздел 1. Симметрия полиэдров. Раздел 2. Симметрия, операции и элементы симметрии. Закрытые симметрические преобразования Раздел 3. Кристаллографические точечные группы. Сингонии решетки и ячейки Бравэ.	Презентация Контрольная работа Индивидуальные задания

РД -3	Владеть методами моделирования и синтеза новых веществ и материалов.	ДПК(У)-1	Раздел 3. Кристаллографические точечные группы. Сингонии решетки и ячейки Бравэ.	Презентация
-------	--	----------	--	-------------

### 3. Шкала оценивания

Порядок организации оценивания результатов обучения в университете регламентируется отдельным локальным нормативным актом – «Система оценивания результатов обучения в Томском политехническом университете (Система оценивания)» (в действующей редакции). Используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов обучения. Итоговая оценка (традиционная и литерная) по видам учебной деятельности (изучение дисциплин, УИРС, НИРС, курсовое проектирование, практики) определяется суммой баллов по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации (итоговая рейтинговая оценка - максимум 100 баллов).

Распределение основных и дополнительных баллов за оценочные мероприятия текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается календарным рейтинг-планом дисциплины.

Рекомендуемая шкала для отдельных оценочных мероприятий входного и текущего контроля

% выполнения задания	Соответствие традиционной оценке	Определение оценки
90%÷100%	«Отлично»	Отличное понимание предмета, всесторонние знания, отличные умения и владение опытом практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, их качество оценено количеством баллов, близким к максимальному
70% - 89%	«Хорошо»	Достаточно полное понимание предмета, хорошие знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, качество ни одного из них не оценено минимальным количеством баллов
55% - 69%	«Удовл.»	Приемлемое понимание предмета, удовлетворительные знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, качество некоторых из них оценено минимальным количеством баллов
0% - 54%	«Неудовл.»	Результаты обучения не соответствуют минимально достаточным требованиям

Шкала для оценочных мероприятий экзамена

% выполнения заданий экзамена	Экзамен, балл	Соответствие традиционной оценке	Определение оценки
90%÷100%	18 ÷ 20	«Отлично»	Отличное понимание предмета, всесторонние знания, отличные умения и владение опытом практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, их качество оценено количеством баллов, близким к максимальному
70% - 89%	14 ÷ 17	«Хорошо»	Достаточно полное понимание предмета, хорошие знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, качество ни одного из них не оценено минимальным количеством баллов
55% - 69%	11 ÷ 13	«Удовл.»	Приемлемое понимание предмета, удовлетворительные знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, качество некоторых из них оценено минимальным количеством баллов
0% - 54%	0 ÷ 10	«Неудовл.»	Результаты обучения не соответствуют минимально достаточным требованиям

#### **4. Перечень типовых заданий**

*Приводятся примеры типовых контрольных заданий по оценочным мероприятиям*

<b>Оценочные мероприятия</b>		<b>Примеры типовых контрольных заданий</b>
1.	Презентация	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Методы исследования пространственного строения вещества</li> <li>2. Кристаллохимия, как наука</li> <li>3. Основатели отечественной кристаллохимии.</li> <li>4. Взаимоотношения кристаллохимии с другими науками</li> <li>5. Точечные группы симметрии</li> <li>6. Симметрия кристаллических многогранников.</li> <li>7. Симметрия пространственных решеток.</li> <li>8. Хиральность</li> <li>9. Плотнейшие шаровые упаковки в кристаллах.</li> <li>10. Открытые операции симметрии</li> <li>11. Дефекты в кристаллах.</li> </ol>
2.	Индивидуальные задания	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Кристаллографические зоны</li> <li>2. Кристаллографическое индицирование</li> <li>3. Типы химической связи в кристаллах</li> <li>4. Основные категории кристаллохимии</li> <li>5. Полярные направления</li> </ol>
3.	Контрольная работа	<p>Вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Семейства точечных групп, категории симметрии, обозначения.</li> <li>2. Правильные системы точек</li> <li>3. Записать класс симметрии в символике Браве.</li> <li>4. Элементы симметрии кристаллических структур с иллюстрациями, правила записи международного символа пространственной группы.</li> <li>5. Показать действие винтовой оси 42 и плоскости зеркального отражения n в ОЦК-решетке.</li> </ol>
4.	Экзамен	<p>Вопросы на экзамен:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пространственная решетка, элементарная ячейка, правила выбора элементарной ячейки.</li> <li>2. Эквивалентные прямые. Полярные направления. Хиральность.</li> <li>3. Понятие о базисе решетки.</li> <li>4. Сингония, элементарные ячейки Браве. Последовательные операции симметрии.</li> <li>5. Координационное число и методика его вычисления в различных структурах (состоящих из атомов одного сорта, из различных атомов).</li> <li>6. Пространственные решетки металлов.</li> <li>7. Кристаллографические индексы плоскости.</li> <li>8. Кристаллографические индексы узла, направления.</li> <li>9. Особенности индицирования в гексагональной сингонии.</li> <li>10. Понятие о межплоскостном расстоянии и квадратичной форме.</li> <li>11. Теоремы о сочетании операций симметрии структур. Пространственные группы симметрии.</li> <li>12. Определение угла между направлениями, между плоскостями, между направлением и плоскостью.</li> <li>13. Дефекты в кристаллах.</li> </ol>

<b>Оценочные мероприятия</b>		<b>Примеры типовых контрольных заданий</b>
		<p>14. Условие перпендикулярности направления и плоскости в кубической сингонии. Условие параллельности направления и плоскости в кубической сингонии.</p> <p>15. Понятие с кристаллографической зоне, оси зоны.</p>

## **5. Методические указания по процедуре оценивания**

<b>Оценочные мероприятия</b>		<b>Процедура проведения оценочного мероприятия и необходимые методические указания</b>
1.	Презентация	Студент представляет презентацию в формате Power Point. Максимальная оценка составляет 4 балла. Оценка производится за качество подготовки презентации и доклада.
2.	Индивидуальные задания	В процессе работы на практических занятиях студент должен выполнить задания. Даётся время на обдумывание заданной проблемы, затем обсуждение. Критерии оценивания: Студент правильно выполнил задание. Показал отличные знания в рамках учебного материала: 3,6- 4 баллов. Студент выполнил задание не в полном объеме, с небольшими неточностями. Показал хорошие знания в рамках учебного материала: 2,8-3,5 баллов. Студент выполнил задание с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала: 0-2,7 баллов).
3.	Контрольная работа	Контрольная работа выполняется письменно на практическом занятии. Выдается вариант с заданием, даётся время на написание ответа. Оценка за выполнение составляет максимально - 4 балла.
4.	Экзамен	Экзамен проводится в письменной и устной формах. Экзаменационный билет содержит 3 теоретических вопроса и один практический в форме задачи. Максимальный балл за экзамен составляет 20 баллов.